

Development of TOSA/ROSA at 10 Gb/s over Wide Temperature Range for Pluggable Optical Module — by Hisataka Fukasawa, Ken Ashizawa, Ryo Kuwahara, Tsutomu Abe, Keiji Satoh and Shoichi Ogita — The authors have successfully developed new TOSA (transmitter optical sub-assembly) and ROSA (receiver optical sub-assembly) with a wide operating temperature range of -5 to 90 deg. C. These devices meet the requirements of an XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) module for DWDM (dense wavelength division multiplexing) networks. TOSA has low power dissipation by using a newly designed EML (electro-absorption modulator integrated laser diode) chip, a good stability of wavelength and a good transmission characteristic at 1600 ps/nm. ROSA contains a high performance APD (avalanche photo diode) chip and a linear TIA (trans-impedance amplifier) with integrated AGC (automatic gain control) in a coaxial type package. ROSA provides high gain as well as good linearity for robust OSNR (optical signal to noise ratio) performance throughout a wide range of input power.

Keywords: TOSA, ROSA, DWDM, XFP, low power dissipation

1. 緒 言

近年の情報通信トラフィックの増加に伴い、主流である 伝送レート 10Gbit/sの幹線系ネットワークでは、複数の 波長を多重して伝送する DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 方式が数多く用いられている。 XFP (10Gbit/s Small Form Factor Pluggable) は小型、 低消費電力な光インターフェースモジュールである。伝送 装置はデータ容量の拡大を目的として1装置あたりのボー ド枚数増加、あるいはボードあたりの XFP 搭載数を増やす 方法が採られる。このため使用される XFP には低消費電力 化や高温動作が要求されている。

今回、我々は高密度実装用 XFP に必須となる 90 ℃まで の動作が可能な送信用/受信用の光素子を開発した。EA変 調器集積レーザを採用した TOSA(Transmitter Optical Sub-Assembly)と、APD(Avalanche Photo Diode) 及び TIA(Trans-impedance amplifier)を搭載した ROSA(Receiver Optical Sub-Assembly)である。

本稿では、それら素子の特性について報告する。

2. 主要諸元

TOSA/ROSAの主要諸元を表1に示す。

XFPでの動作温度範囲が-5~85℃となることから、搭 載されるTOSA/ROSAの動作温度範囲(ケース温度)は-5 ~90℃を想定している。TOSA/ROSAのパッケージは、 XMD-MSA(10Gbit/s Miniature Device Multi Source Agreement)に準拠したもので、TOSAは箱型パッケージ、

表1 TOSA/ROSA の主要諸	元
-------------------	---

20			
動作ケース温度	-5∼90°C		
外形寸法	XMD-MSA 準拠		
光インターフェース	LCレセプタクル		
電気インターフェース	8ピンフレキシブル基板		
伝送速度	9.95~11.3Gbit/s		
TOSA			
中心波長	1528.77~1563.05nm		
光出力パワー	0~4dBm		
動作電流	120mA Max.		
消光比	9dB Min.		
光波形クロスポイント	45%~55%		
伝送ペナルティ(1600ps/nm)	s/nm) 2.0dB Max.		
TEC消費電力	2.0W Max.		
ROSA			
受光感度	感度 0.7A/W Min.		
トランスインピーダンス利得	$4k\Omega$ (Single-ended) Min.		
最小受信感度	-27dBm Max.		
オーバーロード特性	-3dBm Min.		

ROSAは同軸型を採用した。TOSAの光出力は0~4dBm、 TOSA内部に搭載するレーザ温度調整用TEC (Thermoelectric cooler)の消費電力は2.0W以下である。 ROSAにおいては、長距離伝送を実現するためにAPDを 用い、線形性に優れた AGC アンプ集積型 TIA を内蔵した。 APD の受光感度は 0.7A/W 以上、TIA のトランスインピー ダンス利得は 4kΩ (single-ended) 以上、最小受信感度 は-27dBm 以下を達成した。

TOSA/ROSAを使用した伝送特性は、標準シングルモー ドファイバを介して 80km 伝送時(分散量: 1600ps/nm) に、伝送ペナルティ(伝送後の受信感度劣化量) 2.0dB 以 下を実現した。

3. TOSA の諸特性

3-1 構造とインターフェース TOSAの外形を**写真 1**に示す。XMD-MSA準拠のパッケージに電気インター フェースとして8ピンのフレキシブル基板が接続される。 各ピンの機能は図1に示す。

TECの上に実装されたレーザチップからの光を内部のレ ンズで集光し、レセプタクルを介して外部に取り出す。 チップ後方にはパワーモニター用のPD (Photodiode)を 搭載する。

TOSA 内部には今回新たに開発した EA 変調器レーザ (EML: Electro-Absorption Modulator Integrated Laser Diode) チップを搭載している。80km 伝送用で動 作電流を従来よりも低くできるよう改良し、従来品と比べ て同一のレーザ駆動電流で約2dBのパワー増加を実現して



写真1 TOSA 外形



図1 TOSA ブロックダイアグラム



図2 従来チップとの比較

いる(図2)。そのためレーザ駆動電流を抑えることが可能 となり、光インターフェースモジュール用途として低消費 電力設計に対応したものとなっている。

3-2 消費電力 TOSAに搭載されているTECの消 費電力を図3に示す。TOSA が実装された XFP において、 ケース温度が上昇/下降した場合には装置内の制御により TECを冷却素子/加熱素子として機能させ、LD 温度を一 定に保つよう調整する。XFP等の光インターフェースモ ジュールにおいては、このTECでの消費電力が全体の消費 電力に大きく影響する。今回の開発ターゲットである高温 動作タイプのXFPでは動作温度範囲が85℃まで拡張され ているため、TOSA単体でのケース温度範囲は90℃まで としている。図はLD電流が100mAの条件のデータであ る。TEC消費電力はTEC素子自身の発熱およびLDチップ の発熱のため、LDチップを冷却する必要のある高温側で 増加する傾向があるが、最も消費電力が大きくなるケース 温度90℃の場合でもTEC消費電力は2.0Wを大幅に下 回っている。



図3 TEC 消費電力 (駆動条件: TLD = 35 ℃ lop = 100mA)

3-3 光出力波形 図4に光出力波形を示す。(a)は 伝送前(Back to Back)の波形、(b)は80km伝送 (1600ps/nm)後の波形である。駆動条件は所定のパワー が得られるように調整している。ここではレーザ温度を 41℃、駆動電流を90mAに設定している。オフセット電圧 Voは伝送時の特性を保ちつつ、伝送前の光波形の開口が狭 くなりすぎないよう調整する必要があるためVo=-0.5Vに 設定している。波形はどちらもオシロスコープの光プラグ インに内蔵されているベッセルトムソンフィルタ通過後の ものである。伝送前の光出力波形は、10dB以上の消光比 を実現しつつ、STM-64/OC-192で規定されるマスク要求 に対して、20%以上のマスクマージンが得られた。



<u>り 300 μww 9 200 μww 9 361 μwww</u> 9 100 mw/dw 10 mm 167 pordw The Normal 日本 100 km 10

図4 光出力波形

3-4 光波長の安定性 DWDM用途では波長の安定 性は最も重要である。波長が変動する要因としては搭載時の TOSAのケース温度の変化と長期使用時の特性変動がある。

図5に波長のケース温度依存性を示す。温度範囲-5℃から90℃で±5pmと良好な波長安定性を示している。 DWDM用途として十分な性能を持っていることがわかる。

図6に85℃雰囲気中のエージング試験の結果を示す。 3000Hまでの加速試験でも波長変動量は60pm以下であ り、寿命20年で±100pmの目標規格を満足している。



図5 波長のケース温度依存



図6 長期波長安定性

4. ROSAの諸特性

4-1 ROSAの構成 ROSAの外形を**写真2**に、ブロックダイアグラムを**図7**に示す。

同軸型パッケージにはAPDとTIA(いずれも自社開発)、 温度モニタのためのサーミスタ、電源雑音を除去するため のフィルタ回路を内蔵した。電気インターフェースには、 8ピンのフレキシブル基板、光インターフェースにはLCレ セプタクルを採用した。



写真2 ROSA外形



図7 ROSA ブロックダイアグラム

APD はモノリシックレンズを集積した裏面入射型で、広い有効受光径を持つため、高い結合効率を得られる。

TIAは、光電流を電圧に変換する広帯域・低雑音のトラ ンスインピーダンス型アンプ、電圧増幅機能をもつ差動 AGCアンプ、50Ω出力バッファから構成される。

4-2 入出力特性 TIA の小信号におけるトランスイ ンピーダンス利得は6kΩであり、微小信号入力時において も、100mVp-p以上の電圧振幅を出力する。また、高入力 のトランスインピーダンス利得は、AGCアンプによって適 切な値に減衰されるため、図8に示すように使用される入 力パワー範囲にて安定した電圧振幅を得ることができる。



図8 ROSA 入出力特性

4-3 ROSA 電気出力波形 ビットレート 9.95Gb/s (PRBS 2³¹-1: Pseudorandom Binary Sequence)、ケー ス温度 25℃、各入力パワーにおける電気出力波形を**図9**に 示す。-25~-5dBmの入力パワー範囲において、歪の小さ い良好な波形が得られた。



図9 ROSA 電気出力波形

5. 伝送特性

5-1 伝送ペナルティ TOSA/ROSA 対向での伝送 ペナルティの評価結果を以下に示す。

測定系を図10に示す。PPG (Pulse Pattern Generator) での電気振幅は2Vp-pに設定してTOSAを駆動している。 ビットレートは9.95Gbit/s、データパターンはPRBS 2^{31} -1を使用し、伝送路にはシングルモード光ファイバに て、1600ps/nmの分散量に相当する距離で伝送を行った。

ROSAは、APDの増倍率はM=9に設定し、受信識別 点は伝送前後の最適値に固定した。

伝送前後の受信感度を図11に示す。伝送前(分散量: 0ps/nm)の最小受信感度は-26.4dBm、1600ps/nm伝送 後の受信感度は-25.6dBmであり、伝送ペナルティは 0.8dBが得られた。一般的に市場から要求される伝送ペナ ルティは2.0dB以下であるため、本TOSA/ROSAの特性 は十分なマージンを有する。

5-2 OSNR特性 DWDMシステムでは、光増幅器 が多段接続されるため、光増幅器からの自然放出光が蓄積 し、主信号との干渉によりビート雑音を発生する。







図11 伝送特性

DWDM用TOSA/ROSAでは、ビート雑音によって劣化したOSNR(光信号対雑音比:Optical Signal to Noise Ratio) に対する耐力が重要とされる。図12にOSNR耐力を示す。ビットレートは11.1Gbit/s、分散量0ps/nmにて、温度範囲-5~90°Cの環境下で評価を行った。ビットエラーレート1E-3となるOSNRは12dB以下であった。-5~90°Cの広い温度範囲においてもTIAの優れた線形性により、-20~-5dBmの入力パワー範囲で特性変動が小さく、良好なOSNR耐力が得られた。



図12 OSNR特性

6. 結 言

長距離用 DWDM XFP 向けに 90 ℃での動作が可能な送 信用/受信用の光素子の開発に成功した。

新開発のレーザチップ採用により低消費電力を実現しつ つ、DWDM用途に適した波長安定性を持つTOSA特性が 得られた。また、ROSAにおいては、APDと全入力パワー 範囲に対して優れた線形性を持つTIAを搭載することによ り、良好なOSNR耐力を実現している。

用語集

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing (高密度波長 多重伝送):高密度波長分割多重。

XFP

10 Gigabit Small Form Factor Pluggable:活栓挿抜可 能な10Gbit/s対応光トランシーバ。

TOSA

Transmitter Optical Sub-Assembly:送信用小型光デバ イス。

APD

Avalanche Photo Diode:小さな信号レベルまで受信可能なフォトダイオード。

TIA

Trans-impedance amplifier (トランスインピーダンス・ アンプ):フォトダイオードなどの微小電流信号を電気信 号に変換し、増幅するための回路。

ROSA

Receiver Optical Sub-Assembly:受信用小型光デバイス。

XMD-MSA

10Gbit/s Miniature Device Multi Source Agreement: 製品仕様の標準化によりユーザの利便性を高めるとともに 市場規模の拡大を図るため、各社が互換性のある共通仕様 の製品を開発・製品化する取り決め様の製品を開発・製品化 する取り決め。

OSNR

Optical Signal to Noise Ratio:光信号対雑音比。

執筆	至 者一		
深澤	- 」 永考 [*]	:住友電エデバイス・イノベーション(株) 光デバイス開発部 レーザ製品の開発に従事	
芦澤	建 [*]	:住友電エデバイス・イノベーション(株) 光デバイス開発部 受光素子製品の開発に従事	F
桒原	涼	:住友電工デバイス・イノベーション㈱	光デバイス開発部
阿部	務	:住友電エデバイス・イノベーション(株) レーザ開発課課長(Ph.D.)	光デバイス開発部
佐藤	敬二	:住友電エデバイス・イノベーション(株) 担当部長	光デバイス開発部
荻田	省一	:住友電エデバイス・イノベーション(株) 部長(工学博士)	光デバイス開発部

* 主執筆者